

Винахід належить до засобів рентгенодифракційного контролю структурної досконалості монокристалів для виготовлення напівпровідникових і оптоелектронних приладів. За способом інтегральної оцінки структурної досконалості кристалів від поверхні досліджуваного кристала записують криву коливання в геометрії Бреґа, реєструють максимальне значення її інтенсивності R_m та ширину d поблизу підніжжя на рівні $0,2R_m$, встановлюють співвідношення між ними, за значенням якого визначають ступінь досконалості кристалів. Винахід дозволяє підвищити точність оцінки досконалості і дає можливість виконання досліджень на зразках довільної товщини.